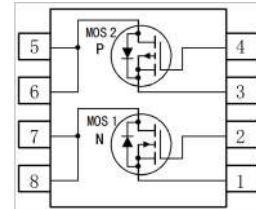
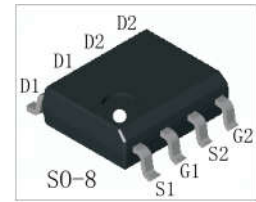


LYNPM8858SP (进口芯片)型 N/P 沟道 MOS 场效应晶体管

特性

- 参照执行标准: QZJ840611, Q/RBJ1019QZ-2015
- 封装形式: S0-8
- 开关速度快, 输入阻抗高, 驱动功耗小, 安全工作区宽, 温度稳定性好
- MOS1: N 沟道 (8.6A; 30V; 17mΩ)
- MOS2: P 沟道 (-7.3A; -30V; 20.5mΩ)
- 产品为非国产化



极限参数

- 贮存温度 T_{stg} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 工作温度 T_{amb} : $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 焊接温度不超过 260°C , 焊接时间不超过 10 秒

类型	额定功率 P_D (W)	额定功率 P_D (W)	漏源击穿电压 BV_{DSS} (V)	栅源击穿电压 BV_{GSS} (V)	漏极电流 I_{DM} (A)	导通电阻 R_{DS} (mΩ)	热阻 $R_{th(j-c)}$ ($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)
MOS1 (N)	1.6 (单芯)	2 (双芯)	30	± 20	8.6	17	40
MOS2 (P)	1.6 (单芯)		-30	± 25	-7.3	20.5	

主要电特性 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	沟道类型	规范值			单位
				最小值	典型值	最大值	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$ $V_{GS}=0\text{V}, I_D=-250\mu\text{A}$	MOS1 (N) MOS2 (P)	30 -30	—	—	V
零栅压漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=24\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$ $V_{DS}=-24\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	1 -1	μA
栅极漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$ $V_{GS}=\pm 25\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	± 10 ± 10	μA
开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$ $V_{DS}=V_{GS}, I_D=-250\mu\text{A}$	MOS1 (N) MOS2 (P)	1 -1	—	3 -3	V
导通电阻	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=8.6\text{A}$ $V_{GS}=-10\text{V}, I_D=-7.3\text{A}$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	17 20.5	mΩ
	$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=7.3\text{A}$ $V_{GS}=-4.5\text{V}, I_D=-5.6\text{A}$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	20 34.5	mΩ
跨导	g_{FS}	$V_{DS}=5\text{V}, I_D=8.6\text{A}$ $V_{DS}=-5\text{V}, I_D=-7.3\text{A}$	MOS1 (N) MOS2 (P)	10 10	—	—	S
电容	C_{ISS}	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$ $V_{DS}=-15\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	1205 2230	pF
	C_{OSS}	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$ $V_{DS}=-15\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	MOS1 (N) MOS2 (P)	—	—	240 390	pF

